## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-338661

(43)Date of publication of application: 08.12.2000

(51)Int.CI.

GO3F 7/023 CO8L 61/06 GO3F 7/039 // CO8G 8/24

(21)Application number: 11-149821

(71)Applicant: SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

28.05.1999

TAKADA YOSHIYUKI

(72)Inventor:

TOMIOKA ATSUSHI

RI SOKO

#### (54) POSITIVE TYPE RESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance resolution without considerable sacrificing other various resist performances by incorporating an alkali-soluble resin, a radiation sensitive component and a low molecular weight alkali-soluble component selected from a specified polyphenol compound and an oligomer containing the polyphenol compound and having a specified weight average molecular weight or below. SOLUTION: The positive type resist composition contains an alkali-soluble resin, a radiation sensitive component and a low molecular weight alkali-soluble component selected from a polyphenol compound of the formula having a molecular weight of ≤ 1,000 and an oligomer containing the polyphenol compound and having a weight average molecular weight of ≤1,000. In the formula, R1-R8 are each H, an alkyl or an alkoxy, Q1 and Q2 are each H or an alkyl, (a) and (b) are each 1, 2 or 3, (c) and (d) are each 1 or 2 and (m) and (n) are each an integer of ≥1.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-338661 (P2000-338661A)

(43)公開日 平成12年12月8日(2000.12.8)

و طرح م

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		設別記号	FΙ			テーマコード(参考)
GO3F	7/023	5 1 1	G03F	7/023	511	2H025
C08L	61/06		C08L	61/06		4J002
G03F	7/039	5 0 1	G03F	7/039	501	4 J 0 3 3
// C08G	8/24		C 0 8 G	8/24		
<u></u>			容查請求	未請求	請求項の数12	OL (全 10 頁)
(21)出願番号	<del>}</del>	特顏平11-149821	(71) 出願人		93 学工業株式会社	
(22)出頭日		平成11年5月28日(1999.5.28)	)			兵4丁目5番33号
			(72)発明者			(т, до дос.)
				大阪市山	比花区春日出中:	3丁目1番98号 住
				友化学コ	工業株式会社内	
			(72)発明者			
						3丁目1番98号 住
			,		二菜株式会社内	
			(74)代理人	10009328	85	
		•		护理士	久保山 隆	(外2名)
			ı			

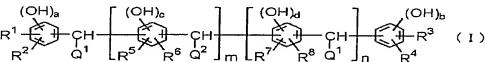
## (54) 【発明の名称】 ポジ型レジスト組成物

#### (57)【要約】

【課題】 解像度が一層改良されたポジ型レジスト組成物を提供する。

【解決手段】 アルカリ可溶性樹脂及び感放射線成分と ともに、下式(I)

最終頁に続く



(式中、 $R^1$   $\sim R^8$  は各々独立に水素、アルキル又はアルコキシ、 $Q^1$  及び $Q^2$  は各々独立に水素又はアルキル、a及び b は各々独立に 1、2 又は 3、c及び d は各々独立に 1 又は 2、m及び n は各々独立に 1 以上の整数を、それぞれ表し、m+n 個存在する各単位の構造は同一でも異なってもよい)で示される分子量 1、000以

下の多価フェノール化合物及び/又はそれを含む重量平均分子量1.000以下のオリゴマーを低分子量アルカリ可溶成分(ただし、mークレゾールのみをホルムアルデヒドで縮合させた化合物又はオリゴマーのみであることはない)として含有するポジ型感放射線性レジスト組成物。

【特許請求の範囲】

有し、さらに、下式(1)

【請求項1】アルカリ可溶性樹脂及び感放射線成分を含

$$\begin{array}{c|c}
(OH)_{a} & (OH)_{b} \\
R^{1} & CH \\
R^{2} & Q^{1} & R^{5} & R^{6} & Q^{2} \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
(OH)_{a} & (OH)_{b} \\
R^{7} & R^{8} & Q^{1} \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
(OH)_{b} & (OH)_{b} \\
R^{7} & R^{8} & Q^{1} \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
(OH)_{b} & (OH)_{b} \\
R^{7} & R^{8} & Q^{1} \\
\end{array}$$

(式中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R²及びR³は各々独立して、水素、アルキル又はアルコキシを表し、Q¹及びQ²は各々独立して、水素又はアルキルを表し、a及びbは各々独立して、1、2又は3を表し、c及びdは各々独立して、1又は2を表し、m及びnは各々独立して、1以上の整数を表し、m+n個存在する各単位の構造は同一でも異なってもよい)で示される分子最1.000以下の多価フェノール化合物及び上記式(I)で示される多価フェノール化合物を含む重量平均分子最1.000以下のオリゴマーから選ばれる低分子量アルカリ可溶成分が、mークレゾールのみをホルムアルデヒド

で縮合させた化合物又はオリゴマーのみであることはない) を含有することを特徴とするポジ型感放射線性レジスト組成物。

【請求項2】式(I)中のQ<sup>1</sup>及びQ<sup>2</sup>がそれぞれ水素である請求項1に記載の組成物。

【請求項3】式(1)中のa、b、c及びdがそれぞれ 1である請求項1又は2に記載の組成物。

【請求項4】低分子量アルカリ可溶成分が、式(1)中のm+nが2又は3である多価フェノール化合物を含有する請求項1~3のいずれかに記載の組成物。

【請求項5】低分子盘アルカリ可溶成分が、下式 (II) 又は (III)

$$R^{1}$$
  $CH_{2}$   $CH_{2}$   $CH_{2}$   $CH_{2}$   $CH_{2}$   $CH_{2}$   $CH_{2}$   $CH_{3}$   $CH_{2}$   $CH_{2}$   $CH_{3}$   $CH_{4}$   $CH_{2}$   $CH_{2}$   $CH_{3}$   $CH_{4}$   $CH_{2}$   $CH_{4}$   $CH_{2}$   $CH_{4}$   $CH_{4}$   $CH_{2}$   $CH_{4}$   $CH$ 

OH OH OH OH OH 
$$R^1$$
  $CH_2$   $CH_2$   $CH_2$   $CH_2$   $CH_2$   $CH_3$  (III)

 (式中、R¹、R²、R²、R³、R¹、R⁵、R²及

 びR®は請求項1に定義したとおりである)で示される

 4核体又は5核体多価フェノール化合物を含有する請求項1に記載の組成物。

【請求項6】多価フェノール化合物が、pークレゾールとキシレノールをメチレンで結合した構造であり、pークレゾールから導かれるフェノール核を両末端に有する請求項5に記載の組成物。

【請求項7】多価フェノール化合物が、4,4'ーメチレンビス〔2-(2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-3,6-ジメチルフェノール〕又は2,6-ビス〔4-ヒドロキシ-3-(2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-2,5-ジメチルベンジル〕-4-メチルフェノールである請求項5に記載の組成物。

【請求項8】 低分子量アルカリ可溶成分が、少なくとも 2 種類の単核フェノール化合物をホルムアルデヒドで縮 合させたオリゴマーを含有する請求項1に記載の組成 物。

【請求項9】 オリゴマーの原料である単核フェノール化合物が、m-又はp-クレゾールを含有する請求項8に記載の組成物。

【請求項10】 単核フェノール化合物が、mークレゾールとpークレゾールである請求項9に記載の組成物。

【請求項11】単核フェノール化合物が、mー又はpークレゾールとキシレノールである請求項9に記載の組成物。

【請求項12】アルカリ可溶性樹脂がノボラック樹脂であって、それをゲル浸透クロマトグラフィーで分析したときに、ボリスチレンを標準品とする分子量1,000以下の範囲の面積比が、未反応の原料フェノール系化合物を除く全パターン面積に対して25%以下のものである請求項1~11のいずれかに記載の組成物。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、アルカリ可溶性制 脂及び感放射線成分を含有し、紫外線、遠紫外線(エキ シマ・レーザー等を含む)、電子線、イオンビーム、X 線等の放射線に感応して、半導体集積回路の微細加工に 好適に用いられるポジ型感放射線性レジスト組成物に関 する。

## [0002]

【従来の技術】半導体集積回路の微細加工には通常、レジスト組成物を用いたリソグラフィープロセスが採用されており、レジスト組成物のなかでもポジ型のものは、一般に解像度に優れることから、多く用いられている。 ポジ型レジストは、一般にアルカリ可溶成分と感放射線

成分を含有するものである。具体的には、アルカリ可溶 性のノボラック樹脂及び感放射線性のキノンジアジド化 合物を含有し、アルカリ不溶性であるキノンジアジド化 合物が放射線の作用により分解してカルボキシル基を生。 じ、アルカリ可溶性になることを利用する人ボラック/ キノンジアジド系のレジストが知られている。

【0003】そして、集積回路については近年、高集積 化に伴う微細化が進み、サブミクロンのパターン形成が 要求されるようになっている。その結果、一層優れた解 像度を示すポジ型レジスト組成物が求められている。こ のようなパターンの微細化に対して、酸発生剤による化 学増幅作用を利用した、いわゆる化学増幅型のレジスト も一部で採用されているが、ノボラック/キノンジアジ ド系レジストに対する需要も依然として根強い。

【0004】ノボラック/キノンジアジド系ポジ型レジ ストの解像度を上げるためには、感放射線性キノンジア ジド化合物の量を増やすことが考えられるが、キノンジ アジド化合物の量を増やしすぎると、レジストの光吸収 が大きくなってプロファイルが悪化し、矩形のパターン 形状が得られなくなるという限界があった。また、特開 20 平 1-105243 号公報などには、分別により高分子量分を 多くしたノボラック樹脂に、m-クレゾールをホルムア ルデヒドで縮合させた低分子量ノボラックオリゴマーを

混合することにより、レジストの感度や耐熱性の改良を 図った例が示されており(同公報の実施例5及び実施例 8) 、さらに特開平 2-2560 号公報や特開平 2-200253 号公報、特開平 3-259149 号公報、特開平 5-204144 号 公報などには、ノボラック/キノンジアジド系のレジス トにノボラック系の3核体多価フェノール化合物を配合 することにより、感度や解像度などを改良することが記 載されている。

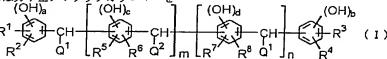
#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、アル カリ可溶性樹脂及び感放射線成分を含有するポジ型レジ ストにおいて、他のレジスト諸性能をあまり犠牲にする ことなく、解像度をより向上させることにある。研究の 結果、アルカリ可溶性樹脂及び感放射線成分を含有する ボジ型感放射線性レジスト組成物に、ある種の化合物を 配合することにより、解像度が一層改良されることを見 出し、本発明を完成した。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、アル カリ可溶性樹脂及び感放射線成分を含有し、さらに、下 式(1)

[0007]



【0008】(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>、 R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>及びR<sup>8</sup>は各々独立して、水素、アルキル又 はアルコキシを表し、QI及びQIは各々独立して、水 30 素又はアルキルを表し、 a 及び b は各々独立して、 l 、 2又は3を表し、c及びdは各々独立して、1又は2を 表し、m及びnは各々独立して、1以上の整数を表し、 m+n個存在する各単位の構造は同一でも異なってもよ い) で示される分子量1,000以下の多価フェノール 化合物及び上記式(I)で示される多価フェノール化合 物を含む重量平均分子量1,000以下のオリゴマーか ら選ばれる低分子量アルカリ可溶成分(ただし、当該低 分子量アルカリ可溶成分が、mークレゾールのみをホル ムアルデヒドで縮合させた化合物又はオリゴマーのみで 40 あることはない)を含有するボジ型感放射線性レジスト 組成物を提供するものである。ここでいう賃量平均分子 量は、ポリスチレンを標準品として、ゲル浸透クロマト グラフィー(GPC)により測定される値である。

## [0000]

【発明の実施の形態】上記式(1)において、R!、R  $^{2}$  、  $R^{3}$  、  $R^{4}$  、  $R^{5}$  、  $R^{6}$  、  $R^{7}$  及び  $R^{8}$  は、それぞ れ水器、アルキル又はアルコキシであり、QI及びQ2 は、それぞれ水素又はアルキルである。ここでのアルキ ル及びアルコキシは、それぞれ1~5個程度の炭素原子 50

を有することができるが、アルコキシの炭素数は1~3 程度で十分である。特に好ましいアルキルはメチルであ り、特に好ましいアルコキシはメトキシである。Q1及 びQ<sup>2</sup> は、原料面などからすると、それぞれ水素である のが有利である。

【0010】また式 (I) において、a、b、c及びd は、各ベンゼン環上に位置する水酸基の数を表し、両端 のベンゼン環上に位置する水酸基の数を表すa及びb は、それぞれ1~3であることができ、中央部の複数の ベンゼン環上に位置する各水酸基の数を表すc及びd は、それぞれ1又は2であることができるが、一般に は、それぞれのベンゼン環上に1個ずつの水酸基を有す るのが、すなわちa、b、c及びdがそれぞれ1である のが有利である。

【0011】本発明では、このような式(1)で示され る分子量1.000以下の多価フェノール化合物自体を 低分子量アルカリ可溶成分として用いるか、又は式

(1) で示される多価フェノール化合物を含む重量平均 分子量1,000以下のオリゴマーを低分子量アルカリ 可溶成分として用いる。もちろん、多価フェノール化合 物自体とオリゴマーとを併用することも可能である。

【0012】まず、式(1)で示される多価フェノール 化合物自体を低分子量アルカリ可溶成分として用いる態 5 4 4,55

様について説明すると、この多価フェノール化合物は、ベンゼン環を4個又はそれ以上有する、すなわち4核体又はそれ以上のものでありうるが、一般には、4核体又は5核体、すなわちm+nが2又は3の化合物であるの

が有利である。具体的に有利な4核体及び5核体多価フェノール化合物は、それぞれ下式(II)及び(III)で表すことができる。

$$R^1 + n$$
が  $2$  又は  $3$  の化合物であるの [0 0 1 3] OH OH OH OH  $R^1 + CH_2 + CH$ 

OH OH OH OH OH 
$$R^1$$
 +  $CH_2$  +  $CH_2$ 

【0014】式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$  及び $R^8$  は先に定義したとおりである。

【0015】式(II) で示される4核体多価フェノール 化合物には、例えば、下式(IIa) の構造を有する4, 4' ーメチレンビス {2- (2-ヒドロキシ-5-メチ ルベンジル) - 3, 6-ジメチルフェノール] や、下式 (IIb) の構造を有する4, 4'-メチレンビス [2-(4-ヒドロキシベンジル) - 3, 6-ジメチルフェノール] などが包含される。

ーメチ 【0016】

$$CH_2$$
 $CH_3$ 
 $CH_2$ 
 $CH_2$ 
 $CH_2$ 
 $CH_3$ 
 $CH_2$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 

【0017】また、式(III) で示される5核体多価フェ ノール化合物には、例えば、 下式(IIIa)の構造を有す る2,6-ビス [4-ヒドロキシー3-(2-ヒドロキ 30 OH \_\_\_\_\_OH\_\_\_

シー5-メチルベンジル)-2, 5-ジメチルベンジル]-4-メチルフェノールなどが包含される。

【0019】なかでも、p-クレゾールから導かれるフェノール核を両末端に有する多核体フェノール化合物、とりわけ、p-クレゾールとキシレノール、特に2,5ーキシレノールとをメチレンで結合した構造の化合物が有利である。上記式(IIa) の構造を有する4,4'ーメ 40チレンビス [2-(2-ヒドロキシー5-メチルベンジル)-3,6-ジメチルフェノール]や、上記式(IIIa)の構造を有する2,6-ビス [4-ヒドロキシ-3-

(2-ヒドロキシー5-メチルベンジル) -2, 5-ジメチルベンジル] -4-メチルフェノールが、このような有利な化合物に該当する。

【0020】式(I)で示される多価フェノール化合物は、例えば、特開平 6-167805 号公報や特開平 9-11409 3 号公報などの記載に準じて、以下に述べる方法により製造することができる。すなわち、下式(IV)

【0022】 (式中、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 、 $Q^1$ 、 $Q^2$ 、 c、 d、m及びn d先に定義したとおりである) で示される 2 mアルコールと、下式(V)及び(V1)

[0023]

(OH)<sub>a</sub> (OH)<sub>b</sub> 
$$R^1 + R^3$$
 (VI)  $R^2$ 

【0024】 (式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>、a及び b は 先に 定義 したとおりである) で示される 単核 フェノール 化合物 とを縮合させる 方法 や、下式 (VII) 【0025】

【0028】(式中、R¹、R²、R³、R¹、Q¹、a及 Ub は先に定義したとおりである)で示される1価アルコールとを縮合させる方法により、式(I)で示される多価フェノール化合物を製造することができる。これらの縮合反応は通常、pートルエンスルホン酸や硫酸、蓚酸のような酸性触媒の存在下で行われる。

【0029】式(VII) で示される多核フェノール化合物 は、市販品があればそれをそのまま用いることができる ほか、例えば、単核フェノール化合物にアルデヒドを反 応させ、単核フェノール化合物を順次つないでいくこと によっても合成できる。出発原料となる単核フェノール 化合物としては、例えば、フェノール、レゾルシノー ル、カテコール、クレゾール、キシレノール、2,3, 5-トリメチルフェノール、メトキシフェノール、エチ ルフェノール、2ーメチルレゾルシノールなどが挙げら れる。これらは、式(I)で示される多価フェノール化 合物の末端フェノール核に導かれる前記式 (V) 又は式 (VI) の単核フェノール化合物ともなりうるが、その他 30 にピロガロールのような3価フェノール化合物も、式 (V) 又は式(VI) に相当する単核フェノール化合物と なりうる。さらに、前記式(VII) で示される多核フェノ ール化合物をアルデヒドと反応させれば、式 (IV) で示 される2価アルコールを製造することができる。前述し た特開平 6-167805 号公報や特開平 9-114093 号公報に 記載される各種の4核体、5核体又は6核体多価フェノ ール化合物が、本発明における低分子量アルカリ可溶成 分として用いられうる。

【0030】次に、前記式(I)の多価フェノール化合物を含む重量平均分子 型1.000以下のオリゴマーを低分子 量アルカリ可溶成分として用いる態様について説明すると、このようなオリゴマーは、先に式(I)の多価フェノール化合物の出発原料として例示したような単核フェノール化合物を、 で酸のような酸触媒の存在下に、アルデヒド、特にホルムアルデヒドと縮合させることにより製造できる。この際の反応条件は、一般的なノボラック 樹脂を製造する場合と基本的に同じであるが、酸触媒を少なめに、例えば、単核フェノール化合物に対して0.001~0.011

$$H = \begin{bmatrix} (OH)_c & (OH)_d \\ CH & CH \\ R^5 & R^6 & Q^2 \end{bmatrix}_{m} \begin{bmatrix} (OH)_d & (VII) \\ R^7 & R^8 \end{bmatrix}$$

【0026】 (式中、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>、R<sup>8</sup>、Q<sup>2</sup>、c、d及びmは先に定義したとおりである) で示される 多核フェノール化合物と、下式(VIII)及び (IX)

HO-CH-
$$\mathbb{R}^3$$
 (IX)

め、例えば、1~5時間程度とすることにより、低分子 虽のオリゴマーを得ることができる。

【0031】本発明におけるオリゴマータイプの低分子 量アルカリ可溶成分としては、少なくとも2種類の単核 フェノール化合物を用い、これらをホルムアルデヒドで 縮合させたものが好ましい。なかでも、原料の単核フェノール化合物がm-又はpークレゾールを含むのが有利 であり、例えば、mークレゾールと、2,3-、2,5-、3,4-又は3,5-キシレノールのようなキシレノールとの組合せなどが挙げられる。とりわけ好ましいものには、pークレゾールとキシレノール、特に2,5-キシレノールとの組合せが包含される。

【0032】本発明のレジスト組成物は、アルカリ可溶性樹脂及び感放射線成分に加えて、以上説明したような低分子量アルカリ可溶成分を含有するものであるが、アルカリ可溶性樹脂及び感放射線成分は、この分野で一般的に用いられているものでよい。アルカリ可溶性樹脂としては、例えば、ボリビニルフェノールやノボラック樹脂などが挙げられ、特にノボラック樹脂が好適に用いられている。ノボラック樹脂は、フェノール系化合物とアルデヒドとを、酸触媒の存在下で縮合させることにより得られる。

【0033】ノボラック樹脂の製造に用いられるフェノール系化合物としては、例えば、フェノール、oー、mー又はpークレゾール、2,3、5ートリメチルフェノール、2ーキシレノール、2,3、5ートリメチルフェノール、2ーtertーブチルー4ー又はーちーメチルフェノール、2ー、4ー又は5ーメチルレゾルシノール、2ー、4ー又は5ーメチルレゾルシノール、2ー、5ー又は3,5ージメトキシフェノール、2ーメトキシフェノール、2ーメトキシフェノール、2ーメトキシンストキシフェノール、4ーtertーブチルカテコール、2ーメトキシソルシノール、4ーtertーブチルカテコール、2,5ー又は3,5ージメチルフェノール、2,5ートリエチルフェノール、キシレノールとヒドロキシトリフェニルメタン系化合物などが挙げられる。これらのフェノール系化合物は、

20

10

それぞれ単独で、又は2種類以上組み合わせて用いるこ とができる。

【0034】ノボラック樹脂の製造に用いられるアルデ ヒドとしては、例えば、ホルムアルデヒド、アセトアル デヒド、プロピオンアルデヒド、ブチルアルデヒド、イ ソブチルアルデヒド、ピバルアルデヒド及びヘキシルア ルデヒドのような脂肪族アルデヒド類、シクロヘキサン アルデヒド、シクロペンタンアルデヒド及びフルフラー ルのような脂環式アルデヒド類、ベンズアルデヒド、o 一、m-又はp-メチルベンズアルデヒド、p-エチル 10 ベンズアルデヒド、2,4-、2,5-、3,4-又は 3, 5-ジメチルベンズアルデヒド、o-、m-又はp ーヒドロキシベンズアルデヒド及びo-、m-又はp-アニスアルデヒドのような芳香族アルデヒド類、フェニ ルアセトアルデヒドのような芳香脂肪族アルデヒド類な どが挙げられる。これらのアルデヒド類も、それぞれ単 独で、又は所望により2種類以上組み合わせて用いるこ とができる。これらのアルデヒド類のなかでは、工業的 に入手しやすいことから、ホルムアルデヒドが好ましく 用いられる。

【0035】フェノール系化合物とアルデヒドとの縮合 に用いられる酸触媒の例としては、塩酸、硫酸、過塩素 酸及び燐酸のような無機酸、蟻酸、酢酸、蓚酸、トリク ロロ酢酸及びpートルエンスルホン酸のような有機酸、 酢酸亜鉛、塩化亜鉛及び酢酸マグネシウムのような二価 金属塩などが挙げられる。これらの酸触媒も、それぞれ 単独で、又は2種類以上組み合わせて用いることができ る。縮合反応は常法に従って、例えば、60~120℃ の範囲の温度で2~30時間程度行われる。

【0036】縮合により得られるノボラック樹脂は、例 30 えば分別などの操作を施して、低分子量分を少なくして おくのが好ましい。 具体的には、ノボラック樹脂をGP Cで分析したときに、分子母1,000以下の範囲の面 積比が、未反応のフェノール系化合物を除く全パターン 面積に対して25%以下、さらには20%以下となるよ うにしておくのが好ましい。ここでパターン面積は、2 54nmのUV検出器を用いて測定したものを意味し、分 子量はポリスチレンを標準品とする値である。分別を行 う場合は、ノボラック樹脂を、良溶媒、例えば、メタノ ールやエタノールのようなアルコール類、アセトンやメ チルエチルケトン、メチルイソブチルケトンのようなケ トン類、エチルセロソルブのようなグリコールエーテル 類、エチルセロソルブアセテートのようなグリコールエ ーテルエステル類、テトラヒドロフランのようなエーテ ル類などに溶解し、この溶液を水中に注いで高分子量分 を沈殿させる方法、あるいはこの溶液を、ペンタン、へ キサン、ヘブタンのような貧溶媒と混合して分液する方 法などが採用できる。

【0037】また、感放射線成分としては通常、キノン ジアジド化合物、具体的には、フェノール性水酸基を有 50

する化合物のoーキノンジアジドスルホン酸エステルが 用いられる。好ましくは、フェノール性水酸基を少なく とも3個有するポリヒドロキシ化合物の1, 2ーナフト キノンジアジドー5ー若しくは-4-スルホン酸エステ ル又は1, 2ーベンゾキノンジアジドー4ースルホン酸 エステルである。このような感放射線性キノンジアジド 化合物は、それぞれ単独で、又は2種類以上組み合わせ て用いることができる。

【0038】これらのエステルは、上記のフェノール性 水酸基を有する化合物を、適当な溶媒中、トリエチルア ミンのような塩基の存在下に、oーキノンジアジドスル ホン酸ハライドと反応させることにより製造できる。反 応後は、適当な後処理を施して、目的物であるキノンジ アジドスルホン酸エステルを取り出すことができる。例 えば、反応マスを水と混合して目的物を析出させ、濾 過、乾燥することにより粉体の形で得る方法や、反応マ スに2-ヘプタノン等のレジスト溶剤を加え、水洗、分 液後、蒸留や平衡フラッシュ蒸留により反応溶媒を除去 し、レジスト溶剤溶液の形で得る方法などがある。ここ でいう平衡フラッシュ蒸留とは、連続蒸留操作の一種で あって、液体混合物の一部を蒸発させ、発生した蒸気相 と液相とを十分に接触させて、平衡に違したときに気体 と液体を分離する蒸留法である。蒸発の効率が非常によ く、ほとんど瞬間的に蒸発が起こり、気相と液相はすぐ に平衡状態に達するので、気相と液相をすぐに分離して も十分に濃縮されており、加熱時間が短くてすむことか ら、熱に弱い物質の濃縮に適している。

【0039】本発明では、以上説明したようなアルカリ 可溶性樹脂及び感放射線成分に加えて、前記式 (1) で 示される多価フェノール化合物及び/又はその多価フェ ノール化合物を含有するオリゴマーを、低分子虽アルカ リ可溶成分として配合する。特に、前述したように低分 子量分を少なくしたノボラック樹脂をアルカリ可溶性樹 脂とし、これに、本発明による低分子量アルカリ可溶成 分を添加することで、高い効果が発揮される。また、本 発明で特定する低分子量アルカリ可溶成分以外に、分子 量1,000以下のアルカリ可溶性フェノール系化合物 を、追加の低分子量アルカリ可溶成分として併用するこ ともできる。併用されるアルカリ可溶性フェノール系化 合物は、分子構造中にフェノール性水酸基を少なくとも 2個有するのが好ましく、例えば、特開平 2-275955 号 公報や特開平 2-2560 号公報、特開平 3-191351 号公報 に記載のものなどが挙げられる。また、本発明の必須成 分からは除外されているmークレゾールのみをホルムア ルデヒドで縮合させた低分子量の化合物又はオリゴマー を、追加の低分子量アルカリ可溶成分とすることももち ろん可能である。

【0040】本発明のレジスト組成物においては、レジ ストのタイプによっても異なるが、一般に、アルカリ可 溶成分、すなわち、アルカリ可溶性樹脂及び低分子量ア

ルカリ可溶成分の合計100重量部に対して、感放射線成分が10~100重量部程度の範囲で用いられる。感放射線成分の好ましい含有量は、上記アルカリ可溶成分100重量部に対して10~50重量部程度である。また、低分子量アルカリ可溶成分は、アルカリ可溶性樹脂と当該低分子量アルカリ可溶成分の合計量を基準に、3~40重量%の範囲で存在させるのが好ましい。さらに、本発明で規定する式(I)の多価フェノール化合物又はそれを含むオリゴマーは、低分子量アルカリ可溶成分のうちの少なくとも10重量%を占めるようにするのが有利である。

【0041】本発明のレジスト組成物は、以上説明したアルカリ可溶性樹脂、感放射線成分及び低分子量アルカリ可溶成分を必須に含有するものであるが、その他必要に応じて、アルカリ可溶性樹脂以外の樹脂や、染料、界面活性剤など、この分野で慣用されている各種の添加物を少量含有することもできる。また、アルカリ分解性の化合物、例えば、特開平 10-213905号公報で提案されているような、アルカリ現像液の作用により分解して酸を生じる酸発生剤を加えることも有効である。このようなアルカリ分解性の化合物を含有させれば、パターンプロファイルの向上に寄与しうる。

【0042】上記の各成分は、溶剤に溶解してレジスト 液とされ、シリコンウェハーなどの基体上に、常法に従 ってスピンコーティングなどの方法で途布される。ここ で用いる溶剤は、各成分を溶解し、適当な乾燥速度を有 し、溶剤が蒸発した後に均一で平滑な途膜を与えるもの であればよく、この分野で通常用いられているものであ ることができる。例えば、エチルセロソルブアセテー ト、メチルセロソルブアセテート、プロピレングリコー ルモノメチルエーテルアセテート及びプロピレングリコ ールモノエチルエーテルアセテートのようなグリコール エーテルエステル類、エチルセロソルブ、メチルセロソ ルブ、プロピレングリコールモノメチルエーテル及びブ ロピレングリコールモノエチルエーテルのようなグリコ ールエーテル類、乳酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル 及びピルビン酸エチルのようなエステル類、アセトン、 メチルイソブチルケトン、2-ヘプタノン及びシクロヘ キサノンのようなケトン類、γーブチロラクトンのよう な環状エステル類などが挙げられる。これらの溶剤は、 それぞれ単独で、又は2種類以上組み合わせて用いるこ とができる。

【0043】基体上に適布され、乾燥されたレジスト膜には、パターニングのために放射線が照射され、次いで必要によりポストエキスポジャーベークが施された後、アルカリ現像液で現像される。ここで用いるアルカリ現像液は、この分野で知られている各種のアルカリ性水溶液であることができるが、一般的には、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドや(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウムヒドロキシド(通称コリン)の水 50

溶液が用いられることが多い。

[0044]

【実施例】次に実施例を挙げて、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によってなんら限定されるものではない。例中、含有量ないし使用量を表す%、部及び割合は、特記ないかぎり重量基準である。また重量平均分子量は、ボリスチレンを標準品としてGPCにより測定した値である。

【0045】参考例1 (ノボラック樹脂の製造) 還流管、攪拌装置及び温度計を備えた5 リットル四つ口 フラスコに、mークレゾール含量61.6%のmー/p ー混合クレゾール702.1g、p-クレゾール379. 2g、蓚酸二水和物25.5g、90%酢酸水溶液33 7.9g、メチルイソブチルケトン1,008g及び水1 23gを仕込んで80℃まで昇温し、そこに37%ホル ムアルデヒド水溶液492.9gを1時間かけて滴下し た。その後還流温度まで昇温し、その状態で12時間保 温した。得られた反応液をメチルイソブチルケトンで希 釈し、水洗及び脱水を行って、ノボラック樹脂を40. 1%含むメチルイソブチルケトン溶液を得た。この樹脂 溶液200gを5リットルの底抜きフラスコに仕込み、 メチルイソブチルケトン335gで希釈し、さらにヘブ タン412gを仕込んで60℃で攪拌し、静置後分液し た。下層のノボラック樹脂溶液を2-ヘプタノンで希釈 してから濃縮し、ノボラック樹脂を36.0%含む2-ヘプタノン溶液を得た。このノボラック樹脂を樹脂Alと する。この樹脂の重量平均分子量は約9.800、GP Cパターンにおける分子量1,000以下の範囲の面積 比は約3.8%であった。

【0046】参考例2(別のノボラック樹脂の製造) 還流管、攪拌装置及び温度計を備えた5リットル四つ口 フラスコに、mークレゾール含量61.6%のmー/p -混合クレゾール1,448.3g、p-クレゾール3 8.62g、蓚酸二水和物35.11g、90%酢酸水溶 液464.4g、メチルイソブチルケトン1.386g及 び水169.23gを仕込んで80℃まで昇温し、そこ に37%ホルムアルデヒド水溶液711.2gを1時間 かけて滴下した。その後還流温度まで昇温し、その状態 で12時間保温した。得られた反応液をメチルイソブチ ルケトンで希釈し、水洗及び脱水を行ってノボラック樹 脂を43.3%含むメチルイソブチルケトン溶液を得 た。この樹脂溶液2,487.4gを底抜き容器に仕込 み、メチルイソブチルケトン6,129.0gで希釈し、 さらにヘプタン 5 , 5 7 2 . 5 g を仕込んで 6 0 ℃で攪拌 し、静置後分液した。下層のノボラック樹脂溶液を2-ヘプタノンで希釈してから濃縮し、ノボラック樹脂を3 3.82%含む2-ヘブタノン溶液を得た。このノボラ ック樹脂を樹脂A2とする。この樹脂の重量平均分子量は 約7.900、GPCバターンにおける分子趾1.000 以下の範囲の面積比は約4.5%であった。

【0047】参考例3 (m-クレゾール/ホルムアルデヒドノボラックオリゴマーの製造)

還流管、攪拌装置及び温度計を備えた3リットルの四つロフラスコに、 $m-\rho$ レゾール1,081g及び蓚酸二水和物2.52gを仕込んで80℃まで昇温し、そこに37%ホルムアルデヒド水溶液242.2gを1時間かけて滴下した。その後還流温度まで昇温し、その状態で3時間保温した。得られた反応液を200torrの減圧下に110℃まで加熱して濃縮した後、さらに、15torrの減圧下で145℃まで加熱して濃縮した。これを2-ヘブタノンで希釈し、水洗及び濃縮を行って、ノボラックオリゴマーを36.1%含む2-ヘブタノン溶液を得た。このオリゴマーは、下式の構造を有するものであり(ただし、式中のpは、重合度に見合う繰り返し数を意味する)、その重量平均分子量は約510であった。これをオリゴマーBXとする。

【0049】参考例4(p ークレゾール/2,5-キシレノール/ホルムアルデヒドノボラックオリゴマーの製造)

200mlの四つロフラスコに、p-クレゾール73.0 g、2,5-キシレノール27.26g及び蓚酸二水和 物0.227gを仕込み、投拌しながら60℃まで昇温 した。そこに37%ホルムアルデヒド水溶液36.53 gを20分かけて滴下し、さらに還流状態まで昇温して 4時間保温した。得られた反応液を200torrの減圧下 30 に110℃まで加熱して濃縮した後、さらに、15torr の減圧下で145℃まで加熱して濃縮した。濃縮マスに 室温で2-ヘプタノンを120g仕込んで溶解させ、イ オン交換水60gで4回洗浄した。水洗後のマスを40 torrまで減圧し、80℃まで昇温して脱水した。その結 果、ノボラックオリゴマーを58.12%含む2-ヘブ タノン溶液を104.11g得た。このオリゴマーは、 下式の各単位がメチレンで結合し、末端がpークレゾー ル又は2,5-キシレノール単位となったものであり、 その重量平均分子量は約750であった。これをオリゴ 40 マーBIとする。

【0051】参考例5 (m-クレゾール/p-クレゾール/ホルムアルデヒドノボラックオリゴマーの製造) 200mlの四つロフラスコに、 m-クレゾール 73. 0g、p-クレゾール73.0g及び蓚酸二水和物0.3 4gを仕込み、提拌しながら60℃まで昇温した。そこに38%ホルムアルデヒド水溶液32.84gを1時間かけて滴下し、さらに還流状態まで昇温して4.5時間保温した。その後、参考例4と同様に後処理を施して、ノボラックオリゴマーを60.59%含む2-ヘプタノン溶液を92.46g得た。このオリゴマーは、下式の各単位がメチレンで結合し、末端がm-クレゾール又はp-クレゾール単位となったものであり、その重量平均分子量は約680であった。これをオリゴマーB2とする。

[0052]

【0053】参考例6(mークレゾール/2,5ーキシレノール/ホルムアルデヒドノボラックオリゴマーの製造)

200mlの四つロフラスコに、mークレゾール73.0g、2,5ーキシレノール27.26g及び蓚酸二水和物0.227gを仕込み、攪拌しながら60℃まで昇温した。そこに39%ホルムアルデヒド水溶液21.92gを30分かけて滴下し、さらに還流状態まで昇温して4.5時間保温した。その後、参考例4と同様に後処理を施して、ノボラックオリゴマーを57.16%含む2ーペプタノン溶液を74.80g得た。このオリゴマーは、下式の各単位がメチレンで結合し、末端がmークレゾール又は2,5ーキシレノール単位となったものであり、その重量平均分子量は約490であった。これをオリゴマーB3とする。

[0054]

【0055】実施例1~6及び比較例1

参考例1及び2のようにして得られたノボラック樹脂AI及びA2の各溶液を固形分割合5/95又は2.5/97、5で混合して、以下の物性を有する樹脂AII及び樹脂AI2の各溶液とした。

【0056】 樹脂AII: AI/A2=5/95、重量平均分子量約7,950、GPCパターンにおける分子量1,000以下の範囲の面積比約4.4%。

樹脂A12: A1/A2=2.5/97.5、重量平均分子量約7,930、GPCパターンにおける分子量1,000以下の範囲の面積比約4.5%。

【0057】また感放射線成分として、下式 【0058】

【0059】の構造を有する4-(7-ヒドロキシー 2, 4, 4-トリメチルー2ークロマニル) レゾルシノ ールと1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸 クロリドとの反応モル比1:2.6の縮合物を用いた。 【0060】さらに、低分子量アルカリ可溶成分(1)と して、参考例3~6で得た以下に再掲するオリゴマーBX 10 分(2)として、下式 及びB1~B3、並びに以下に示す多核体多価フェノール化 合物C1~C3を用いた。

【0061】BX: 参考例3で得られたm-クレゾール /ホルムアルデヒドノボラックオリゴマー (重量平均分 子虽約510)。

B1: 参考例 4 で得られた p - クレゾール/ 2, 5-キ シレノール/ホルムアルデヒドノボラックオリゴマー (重量平均分子量約750)。

B2: 参考例5で得られたm-クレゾール/p-クレゾ ール/ホルムアルデヒドノボラックオリゴマー (重盘平 20 均分子母約680)。

B3: 参考例 6 で得られたm-クレゾール/2.5-キ シレノール/ホルムアルデヒドノボラックオリゴマー (重量平均分子量約490)。

C1: 前記式(IIa) の構造を有する4, 4'ーメチレン ビス〔2-(2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-

## 3.6-ジメチルフェノール)。

C2: 前記式(IIIa)の構造を有する2, 6-ビス [4-ヒドロキシー3ー (2-ヒドロキシー5-メチルベンジ ル) -2, 5-ジメチルベンジル] -4-メチルフェノ ール。

C3: 前記式(IIb) の構造を有する4, 4' -メチレン ピス〔2-(4-ヒドロキシベンジル)-3,6-ジメ チルフェノール)。

【0062】さらにまた、別の低分子量アルカリ可溶成

[0063]

【0064】の構造を有する4-(1', 2', 3', 4', 4' a, 9' a - ヘキサヒドロー6' - ヒドロキ シスピロ[シクロヘキサン-1, 9'ーキサンテン]ー 4' aーイル) レゾルシノールを用いた。

【0065】これらの各成分を、溶剤とともに以下の組 成で混合し、溶解した。

[0066]

ノボラック樹脂 (固形分量、種類は表1に記載) 9.73 部 感放射線成分 3.5 部 低分子量アルカリ可溶成分(1)(固形分量、種類は表1に記載) 1.0 部 低分子量アルカリ可溶成分(2) 3.6 部 溶剤:2-ヘプタノン 25.5 部 乳酸エチル 25.5 部 ・ 2-ヘプタノンは樹脂溶液及びオリゴマー溶液からの持ち込み分を含む。

【0067】それぞれの溶液をフッ素樹脂フィルターで 濾過してレジスト液を調製し、そのレジスト液を、ヘキ サメチルジシラザンで処理したシリコンウェハーにスピ

ンコートし、ダイレクトホットプレート上にて90°Cで 6 0 秒間のプリベークを行って、膜厚 1.0 6 μ mのレジ スト膜を形成させた。こうしてレジスト膜が形成された ウェハーに、 i 線ステッパー [(株)ニコン製の "NSR-20 40 05 i9C"、NA=0.57 、σ=0.60 〕を用い、露光量を段階 的に変化させてラインアンドスペースパターンを露光し た。次にホットプレート上にて、110℃、60秒の条 件でポストエキスポジャーベークを行った後、2.38

%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60 秒間のパドル現像を行った。現像後のパターンを走査型 電子顕微鏡で観察し、それぞれの実効感度及び解像度を 以下のようにして評価し、結果を表1に示した。

【0068】 実効感度: 1.00 μ m ラインアンドスペ ースパターンの断面幅が1:1となる露光量で表示し た。

【0069】解像度: 実効感度の露光量で分離するラ インアンドスペースパターンの最小線幅で表示した。

[0070] 【表1】

例 No. 樹脂 低分子量T/dJJ可溶成分(1) 実効感度 解像度

実施例1 A11 C1 0.5部+BX 0.5部 65 msec 0.50 иш A11 C2 O.5部+BX O.5部 70 msec 0.475 µ m *n* 3 A11 C3 0.5部+BX 0.5部 60 msec 0.525 µ m

" 4 A12 B1 1.0部 51 msec  $0.55~\mu$  m 11 5 A12 B2 1.0部 48 msec 0.55 μm 6 A12 B3 1.0部 48 msec  $0.525 \mu m$ 比較例 A11 BX 1.0部 50 msec 0.575 μm

【0071】表1に示したように、実施例のものは、比較例のものに比べて解像度が向上している。

[0072]

【発明の効果】本発明のポジ型レジスト組成物は解像度 10 化に有効である。

に優れており、またプロファイル、感度、耐熱性、焦点 深度などのレジスト諸性能のバランスにも優れている。 したがってこの組成物は、半導体集積回路の一層の微細 化に有効である

18

フロントページの続き

(72) 発明者 李 相昊

大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住 友化学工業株式会社内 F ターム(参考) 2H025 AA02 AB16 AC01 AC04 AC05 AC06 AC07 AC08 AD03 BE00 BE01 CB29 CB45 CB52 CB55 CC20 4J002 CC051 CC061 EQ036 EV246 FD206 CP03 CQ05 4J033 CA01 CA02 CA12 CA29 HA02

HAO7 HAO8 HA12 HB10